

描述:

- T0-3PB 塑封封装 NPN 半导体三极管

用途:

- 通用
- 应用 55W 音频功率输出

特性:

- 与 2SA1940 互补
- 环保 (ROHS) 产品

外观 / Package:

- 封装/Package:T0-3PB
- 印记/Marking:C5197

DESCRIPTIONS:

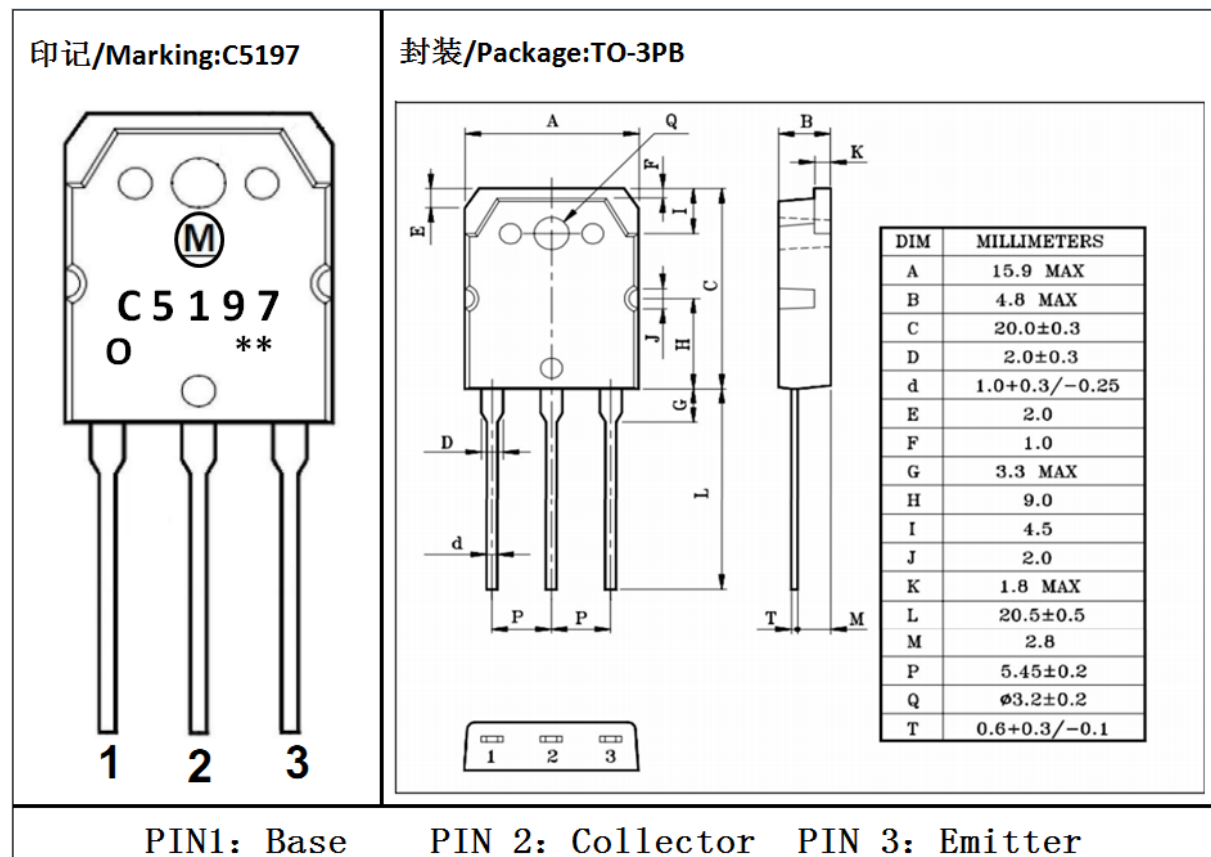
- Silicon NPN transistor in a T0-3PB Plastic Package

APPLICATIONS:

- General purpose
- For 55W audio frequency amplifier output stage

FEATURES:

- Complementary to 2SA1940.
- ROHS Product



热特性 / THERMAL CHARACTERISTIC:

项 目 Parameter	符号 Symbo	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit
节到管壳的热阻 Thermal Resistance Junction Case T0-3PB	$R_{th(j-c)}$	—	1.65	°C/W

最大额定参数 / Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
集电极—基极直流电压 Collector — Base Voltage	V_{CBO}	120	V
集电极—发射极直流电压 Collector — Emitter Voltage	V_{CEO}	120	V
发射极—基极直流电压 Emitter — Base Voltage	V_{EBO}	5	V
集电极电流 Collector Current	I_C	8	A
基极电流 Base Current	I_B	0.8	A
集电极耗散功率 Collector Dissipation (Tc=25°C)	P_C	60	W
结温 Junction Temperature	T_j	150	°C
贮存温度范围 Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
VCBO	IC=1.0mA IE=0	120			V
VCEO	IC=50.0mA IB=0	120			V
VEBO	IE=1.0mA IC=0	5.0			V
ICBO	VCB=120V IE=0			5.0	μA
IEBO	VEB=5.0V IE=0			5.0	μA
hFE(1)	VCE=5.0V IC=1.0A	55		160	
hFE(2)	VCE=5.0V IC=4.0A	35	75		
VCE(sat)	IC=6.0A IB=0.6A			2.0	V
VBE	VCE=5.0V IC=4.0A		0.9	1.5	V
fT	IC=1.0A VCE=5.0V f=100MHz		30		MHz
Cob	VCB=10V IE=0 f=1.0MHz		120		pF

放大及印章代码 / hFE Classifications & Marking

印章代码/ Classifications & Marking	R	O
放大/hFE Range	55~110	80~160

特征曲线 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

